第十二课：III-V族化合物半导体

Thursday, November 28, 2019 12:26 AM

1. 常见III-V族二元化合物的禁带宽度：
    a. GaN：直接3.42eV；
    b. GaP：间接2.26eV；
    c. GaAs：直接1.43eV；
    d. InP：直接1.35eV；
2.